

杭州士兰微电子股份有限公司

对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“士兰微”）与厦门半导体投资集团有限公司于 2017 年 12 月 18 日在中国厦门共同签署了《关于化合物半导体项目之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），双方合作在厦门市海沧区建设一条 4/6 吋兼容的化合物半导体生产线，总投资 50 亿元，其中一期总投资 20 亿元，二期总投资 30 亿元。根据《投资合作协议》，双方在厦门市海沧区共同投资设立了厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称“士兰明镓”）。

士兰明镓最新的股权结构及实收资本情况如下所示：

股东名称	认缴注册资本(万元)	实缴注册资本(万元)	持股比例(%)
厦门半导体投资集团有限公司	82,925.9	82,925.9	65.28
杭州士兰微电子股份有限公司	44,111.1	44,111.1	34.72
合计	127,037.0	127,037.0	100

上述事项详见公司于 2017 年 12 月 19 日、2018 年 1 月 12 日、2018 年 2 月 6 日、2019 年 11 月 9 日、2021 年 11 月 30 日和 2021 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告，公告编号为临 2017-068 号、临 2018-001 号、临 2018-010 号、临 2019-047 号、临 2021-072 号和临 2021-080 号。

二、投资进展情况

截至 2021 年底，士兰明镓已完成第一期 20 亿元的投资，形成了每月 7.2 万片 4 英寸 GaN 和 GaAS 高端 LED 芯片的产能，其产品在小间距显示、mini LED 显示屏、红外光耦、安防监控、车用 LED 等领域得到广泛应用。

士兰明镓启动化合物半导体第二期建设，即实施“SiC 功率器件生产线建设项目”。士兰明镓拟建设一条 6 吋 SiC 功率器件芯片生产线，项目总投资为 15 亿元，建设周期 3 年，最终形成年产 14.4 万片 6 吋 SiC 功率器件芯片的产能（主

要产品为 SiC MOSFET、SiC SBD）。本项目已于 2022 年 7 月 29 日取得了《厦门市企业投资项目备案证明》（编号：厦海工信投备（2022）247 号）。

本项目符合国家产业政策，属于重点鼓励建设的项目。士兰明镓作为士兰微化合物半导体产品的主要供应商之一，本项目是实现士兰微在电动汽车、新能源市场整体战略布局的规划之一，有利于加快实现士兰微 SiC 功率器件的产业化，满足日益增长的新能源领域的市场需求，推动士兰微主营业务持续成长。

后续公司将根据项目进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 30 日